11;12 Энергия разрушения адсорбированной пленки окиси углерода на монокристалле вольфрама

© О.Л. Голубев, В.Н. Шредник

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 7 февраля 2000 г.

В полевом эмиссионном микроскопе исследовались адсорбция и десорбция окиси углерода на монокристалле вольфрама. Наиболее интересные эффекты наблюдались при десорбции в окружении граней куба {100}. По мере десорбции к полюсам $\langle 100 \rangle$ стягивалась электроположительная пленка, сохранявшая резкую границу. Энергия десорбции, определенная по скорости движения границы (по методу прямых Аррениуса), равная $3.4 \pm 0.1 \, eV$, свидетельствовала о значительной прочности пленки окиси углерода. Поведение десорбирующейся фазы СО в областях {100} W можно непротиворечиво объяснить, допустив, что эта фаза образована сеткой диполей СО, нормальных к поверхности и обращенных атомом углерода к вакууму.

В данной работе методами полевой электронной микроскопии исследовались адсорбция и десорбция окиси углерода на монокристалле вольфрама. Интерес к такого рода работам обусловлен возможностью наблюдения динамики процессов десорбции с высоким пространственным разрешением. Методами полевой электронной микроскопии изучались двумерные фазы на монокристаллическом скругленном кристаллеострие, характеризующиеся разным типом межатомного взаимодействия внутри фазы. Притяжение адатомов друг к другу типично для ряда металлических адсорбатов в системах Zr–W [1], Hf–W [2], Hf–Mo [3] и т.п., тогда как для щелочных металлов с сильно поляризованными атомами характерно расталкивание в пределах фазы, это типично, например, для Cs на W [4], Na на W [5] и др.

Работа посвящена развитию подобного рода исследований для газовых пленок, у которых, в принципе, возможны оба типа латерального взаимодействия. При этом весьма интересным оказывается вопрос о термической стойкости адсорбированной пленки.

40

Адсорбция остаточных газов в отпаянном стеклянном приборе производилась в течение стандартного времени 1h при комнатной температуре Т. Такая экспозиция давала покрытие несколько больше моноатомного в вакууме $\sim 5 \cdot 10^{-10}$ Torr. Эмиссионная картина при этом слабо отличалась от чистого вольфрама (рис. 1, а). Слабый прогрев такого состояния при T = 500 К приводит к характерной картине (рис. 1, b) с темным косым крестом вдоль зонных линий (111), содержащих грани типа {110}, {112}, {123}. Согласно данным работы [6], при прогреве покрытия CO на W в интервале T = 300-400 K происходит десорбция физадсорбированного состояния СО и на поверхности остается только хемисорбированный СО. Такие картины, сопровождающиеся заметным повышением работы выхода φ , типичны для адсорбции ряда простых газов (H₂, N₂, CO, H₂O, O₂ [7-11]), однако при десорбции эволюции эмиссионных картин индивидуальны. То, как десорбция происходит в нашем случае (рис. 1, c-e), указывает на наличие в адсорбированном слое окиси углерода CO и примеси H₂.

Прогрев состояния типа рис. 1, *b* при T = 640-900 К вызывает исчезновение темного креста вдоль зонных линий (111) и формирование картины псевдочистого вольфрама (рис. 1, *c*). Согласно [12], при таких низких *T* полностью десорбируется только молекулярный водород. График Аррениуса для подобной десорбции (рис. 2, *a*) дал величину энергии активации $Q_d = 0.49 \pm 0.06$ eV и предэкспоненциальный множитель $\tau_0 = 8 \cdot 10^{-2}$ s. Согласно [12], величина Q_d для молекулярного водорода, адсорбированного на вольфраме, составляет $Q_d \approx 1$ eV при покрытиях $\theta = 0.15-0.45$ монослоя и резко падает с ростом покрытия до $Q_d = 0.15-0.2$ eV при $\theta \ge 0.6$. Таким образом, в нашем случае количество водорода составляет $\theta \sim 0.5$.

Дальнейший рост *T* вызывает в интервале T = 1200-1400 К десорбцию СО с характерным движением фронта пленки к областям вокруг граней куба {001} СО (рис. 1, *d*, *e*). После достижения состояния, показанного на рис. 1, *e*, движение фронта прекращается и покрытие десорбируется, с постепенным исчезновением контраста на эмиссионной картине. График Аррениуса для десорбции СО, показанный на рис. 2, *b*, дал величину $Q_d = 3.43 \pm 0.05$ eV и $\tau_0 = 4 \cdot 10^{-12}$ s.

Хорошо известно, что молекула СО адсорбируется на W без диссоциации и также десорбируется. В противном случае могла бы наблюдаться карбидизация W при нагреве его в атмосфере СО. Подобная карбидизация легко наблюдается при прогреве W в парах различных



Puc. 1. Полевые эмиссионные изображения поверхности W в процессе адсорбции остаточных газов: a — исходный чистый W (радиус острия $r = 0.6 \,\mu$ m, $U_{10} = 6350$ V, U_{10} — напряжение, необходимое для получения эмиссионного тока i = 10 nA); b — после адсорбции в течение t = 1 h и прогрева при T = 500 K, t = 15 s, $U_{10} = 6400$ V; c — после десорбции H₂ при T = 900 K, t = 30 s, $U_{10} = 6200$ V; d — после прогрева при T = 1265 K, t = 100 s, $U_{10} = 6129$ V; e — после прогрева при T = 1265 K, t = 250 s, $U_{10} = 6100$ V.



Рис. 2. Графики Аррениуса для десорбции $H_2(a)$, и СО (b). Для (a) исходное состояние — рис. 1, *b*, конечное — рис. 1, *c*. Для (b) исходное — рис. 1, *d*, конечное — рис. 1, *a*.

углеводородов, однако ни в одной из ранее выполненных работ по взаимодействию СО с W, ни в данной работе никаких следов науглероженного вольфрама не наблюдалось.

Обращают на себя внимание два интересных факта. Во-первых, пленка СО в областях {001} выглядит на эмиссионной картине светлой, т.е. должна понижать исходную работу выхода (φ) граней W. Согласно работе [13], адсорбция СО вызывает заметное повышение φ вольфрама, если СО адсорбируется на переходных металлах атомами углерода к подложке [14,15]. Однако в работе [6] с помощью метода термодесорбции показано, что СО на грани {001} W присутствует в пяти состояниях: первичном адсорбированном состоянии, десорбирующемся при $T_d = 220$ K, физадсорбированном с $T_d = 360$ K и трех хемосорбированных состояниях β_1 , β_2 и β_3 с $T_d = 930$ K, 1070 K и 1375 K соответственно. Все состояния, кроме β_3 , повышают исходную φ грани {001} W, а наиболее высокотемпературное β_3 -состояние, начиная с T > 820 K, вызывает слабое понижение φ на величину $\Delta \varphi = -0.1$ eV при T = 1000 K, при T > 1200 K величина φ достигает φ исходной

грани $\{001\}$ W. Именно десорбция этого состояния и наблюдается на рис. 1, d, e со слабым эмиссионным контрастом.

Во-вторых, легко видеть из рис. 1, d, e, что пленка CO десорбируется с резкой границей, т. е. СО ведет себя как адсорбат с притягивательным латеральным взаимодействием. При этом после достижения состояния рис. 1, *d*, *e* движение фронта (а это области граней $\{310\}-\{311\}$) прекращается и покрытие только десорбируется, исчезая на эмиссионной картине. В этих областях террасы ступени переходят от структуры типа {110}, {112} к террасам типа {100}. Вблизи {100} ступени шире и молекулы — диполи СО, расположенные в потенциальных ямах подложки, оказываются дальше друг от друга. В то же время в областях {311}-{310} расположение диполей ближе и возможно их латеральное притягивательное взаимодействие за счет свободных С-С связей, превышающее некоторое кулоновское расталкивание диполей. Это может объяснить существование резкой границы слоя и ее движение в данных областях на поверхности острия. Взаимное притяжение диполей СО не укладывается в схему их расположения углеродом к подложке и кислородом в сторону вакуума. В последнем случае между атомами кислорода существует только отталкивательное взаимодействие.

В описываемых экспериментах происходит именно десорбция, а не двумерная сублимация пленки СО. Это подтверждает тот факт, что после получения состояния типа рис. 1, *е* и последующего понижения *T* движения светлого фронта пленки в обратном направлении (в сторону граней {112} и центральной грани {110}), т.е. процесса двумерной конденсации, не наблюдается. Наконец, энергия десорбции, измеренная в описанных опытах ($3.4 \, eV$), достаточно велика. Пленка СО весьма прочна. Ее разрушение требует затрат энергии как на разрыв связи с подложкой, так и на разрыв связей внутри пленки.

Все наблюдаемые факты уложатся в логически оправданную картину, если допустить, что в окружении полюсов (100) СО на W при определенных условиях образует плотную сетку диполей, расположенных нормально к поверхности и обращенных атомами углерода в сторону вакуума.

Такой слой диполей обеспечивает некоторую электроположительность. Вместе с тем атомы углерода с ненасыщенными связями могут обеспечить притяжение между диполями. С другой стороны, связь СО с вольфрамом через кислород с большей вероятностью обеспечивает десорбцию СО без диссоциации. Карбидная связь W–C могла бы быть прочнее, чем связь через кислород.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 97–02–18066.

Список литературы

- [1] Одишария Г.А., Шредник В.Н. // ДАН СССР. 1968. Т. 182. С. 542–544.
- [2] Голубев О.Л., Судакова Т.И., Шредник В.Н. // ЖТФ. 2000. Т. 70.
- [3] Шредник В.Н. // Проблемы современной кристаллографии / Под ред. Б.К. Вайнштейна, А.А. Чернова. М.: Наука, 1975. С. 150–171.
- [4] Гаврилюк В.М., Наумовец А.Г., Федорус А.Г. // ЖЭТФ. 1966. Т. 51. № 5. С. 1332–1340.
- [5] Клименко Е.В, Медведев В.К. // ФТТ. 1968. Т. 10. № 7. С. 1986–1990.
- [6] Wang C., Gomer R. // Surf. Sci. 1979. V. 90. № 1. P. 10-36.
- [7] Gomer R., Wortman R., Lundry R. // Journ. Chem. Phys. 1957. V. 26. N 5. P. 1147–1164.
- [8] Worthman R., Gomer R., Lundy R. // Journ. Chem. Phys. 1957. V. 27. N 5.
 P. 1099–1117.
- [9] Gomer R., Hulm J.K. // Journ. Chem. Phys. 1957. V. 27. N 6. P. 1363-1376.
- [10] Ehrlich G., Hudda F.G. // Journ. Chem. Phys. 1961. V. 35. N 4. P. 1421-1439.
- [11] Engel T., Gomer R. // Journ. Chem. Phys. 1969. V. 50. N 6. P. 2428-2446.
- [12] Gomer R. // Field emission and field ionization. USA: Harv. Univ. Press. Cambridge, 1961. P. 125–126.
- [13] Klein R. // Journ. Chem. Phys. 1959. V. 31. N 5. P. 1306-1315.
- [14] Madey T., Czyzewski J., Yates J.T. // Surf. Sci. 1976. V. 57. P. 580-590.
- [15] Behm R.J., Christmann K., Ert G. Journ. Chem. Phys. 1980. V. 73. N 6. P. 2984–2995.